

а 2007 0334

Изобретение относится к способу получения тонких пленок оксидных полупроводников, в частности  $\text{In}_2\text{O}_3$ . Способ включает осаждение пленок посредством спрей пиролиза при температуре  $450\text{...}550^\circ\text{C}$  из водных растворов  $\text{InCl}_3$  с концентрацией соли металла в растворе превышающей  $0,2\text{M}$  с последующим отжигом в нейтральной или кислородсодержащей атмосфере при температуре не менее  $1000^\circ\text{C}$ . Результат изобретения заключается в получении высокотекстурированных в направлении (100) пленок толщиной  $200\text{...}3000\text{ нм}$  с большим размером кристаллографически плоской поверхности кристаллитов.

П. формулы: 1

Фиг.: 3